07

Нелинейное фотовозбуждение гетероструктур с глубокими квантовыми ямами. І. Вероятности элементарных процессов

© Е.Ю. Перлин, М.А. Бондарев, А.В. Иванов, А.А. Попов

Центр "Информационные оптические технологии", Университет ИТМО, 199034 Санкт-Петербург, Россия

e-mail: perlin@mail.ifmo.ru

Поступила в редакцию 14.08.2018 г.

Вычислены вероятности различных типов оптических процессов, участвующих в формировании фотонной лавины в гетероструктурах типа I с глубокими квантовыми ямами. В числе этих процессов двухэлектронные переходы с участием фотона, фотопереходы между электронными состояниями подзон размерного квантования и непрерывного зонного спектра, двухфотонные межзонные переходы в квантовых ямах. Полученные вероятности будут использованы в следующих частях работы для анализа кинетики фотонной лавины.

DOI: 10.21883/OS.2018.12.46943.237-18

1. Введение

Интерес к явлениям типа фотонной лавины (ФЛ), сохраняющийся в течение уже ряда десятилетий, в основном направлен на исследование этого класса процессов в системах примесных редкоземельных ионов (РЗИ, см., например, [1-21]). Было установлено, что за счет фотонно-лавинной апконверсии в системах РЗИ возможно достижение инверсии заселенностей и получение лазерной генерации на длинах волн, существенно меньших длины волны возбуждающего света. Как показано в работах [22-25], эффект фотонной лавины (ЭФЛ) может быть получен и в гетероструктурах с глубокими квантовыми ямами (КЯ). Уже в [22,23] было отмечено, что процессы, формирующие ФЛ, протекают в КЯ существенно быстрее, чем в РЗИ, так как межподзонные оптические переходы в КЯ характеризуются более высокими по сравнению с переходами в РЗИ силами осцилляторов. Кроме того, более высокой по сравнению с РЗИ оказываются и скорости процессов релаксации за счет быстрых внутри- и межподзонных переходов с участием фононов. Характерные времена установления квазиравновесных заселенностей электронных состояний составляют единицы ms для систем РЗИ и единицы ns для КЯ. Столь быстрое протекание ЭФЛ в КЯ наряду с четко выраженным пороговым характером ЭФЛ может быть использовано для быстрых оптических переключений.

Предложенный в работах [22,23] механизм ФЛ в глубокой КЯ с тремя подзонами размерного квантования при энергии кванта возбуждающего света $\hbar\omega$, равной энергетическому зазору между 3-й и 2-й подзонами (рис. 1), может функционировать при наличии достаточно высокой концентрации n_{c_1} электронов в 1-й (нижней) подзоне, что имеет место в случае легированных КЯ¹ В отсутствие легирования электроны могут попадать в

1-ю подзону за счет двухфотонных переходов (ДФП) носителей из валентной зоны. В работах [24,25] было показано, что пороговая интенсивность света j_{th} , необходимая для запуска ФЛ, быстро снижается с увеличением n_{c_1} . Поэтому в [24,25] был дополнительно рассмотрен процесс оже-типа, при котором электрон из верхней подзоны c_3 переходит в нижнюю подзону c_1 , отдавая высвободившуюся энергию $\hbar\omega_{31}$ на переход другого электрона из валентной зоны в ту же подзону c_1 . Этот нелинейный по концентрациям частиц процесс в принципе тоже является "лавинообразующим", но он возможен лишь при малой ширине запрещенной зоны $E_g < \hbar\omega_{31}$ материала в области КЯ. При этом требуется



Рис. 1. Переходы, формирующие фотонную лавину в глубокой легированной квантовой яме: вертикальная линия 1 со стрелкой соответствует прямым резонансным фотопереходам между подзонами c_2 и c_3 , вертикальная сплошная линия и почти горизонтальная пунктирная линия 2 со стрелками описывают слабый непрямой (с участием фонона) переход между подзонами c_1 и c_2 , наклонными штрихпунктирными линиями 3со стрелками показан процесс оже-типа с $c_3 + c_1 \rightarrow 2c_2$.

¹ Вероятности показанных на рис. 1 оптических переходов и переходов оже-типа внутри КЯ для электронов, рассчитанные в [22,23], в настоящей работе не рассматриваются.

также выполнение условия $E_g > \hbar\omega_{32}$, иначе мы будем иметь дело с обычным каскадным поглощением, которое в контексте рассматриваемой задачи не представляет интереса. Ясно, что выполнение указанных двух условий чрезвычайно ограничивает число структур, где такие оже-процессы возможны.

В выполненных ранее работах по ЭФЛ в системах РЗИ и в КЯ учитывались лишь процессы, в которых поглощение (испускание) фотонов и передача энергии между электронами относились к различным элементарным квантовым переходам. В настоящей работе (и в следующих работах) будет показано, что существенную роль в формировании ФЛ в КЯ могут играть процессы, где поглощение фотона и передача энергии происходят в рамках одного элементарного акта. Для объемных материалов такие процессы рассматривались ранее в работах [26-35]. Для случая глубоких КЯ с зонной схемой типа I результаты выполненного впервые расчета вероятности такого процесса приводятся в следующих разделах. Затем будут также приведены результаты расчетов других оптических переходов, участвующих в процессе ФЛ.

2. Система с глубокими квантовыми ямами. Волновые функции

Мы рассматриваем зонную структуру типа I, где область материала с меньшей шириной запрещенной зоны является ямой как для электронов, так и для дырок (рис. 2). По-прежнему предполагаем, что зонные и геометрические параметры КЯ для электронов таковы, что в ней имеется 3 подзоны размерного квантования. Частота возбуждающего лазерного излучения ω выбирается равной частоте перехода ω_{32} между второй и третьей подзонами, но большей частоты ω_{21} перехода между первой и второй подзонами. Глубина ямы для электронов Uc обычно превышает глубину ямы для дырок Uv. Для определенности (хотя это не принципиально) предполагаем, что в яме для дырок имеется лишь одна подзона размерного квантования. Предполагаем также, что энергетический зазор между потолком первой подзоны для дырок и дном второй подзоны для электронов не превышает 2 ћ ...

Волновые функции электронных состояний в КЯ в однозонном приближении даются выражением

$$\psi_{n,\mathbf{k}_{\parallel}}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k}',\mathbf{R}_{i}} e^{i\mathbf{k}_{\parallel}\mathbf{R}_{i}} \varphi_{n}(\mathbf{R}_{i\perp}) e^{i\mathbf{k}'(\mathbf{r}-\mathbf{R}_{i})}$$
$$\times \varphi_{n}(\mathbf{R}_{i\perp}) e^{i\mathbf{k}'(\mathbf{r}-\mathbf{R}_{i})} u_{n,\mathbf{k}'}(\mathbf{r}), \qquad (1)$$

где \mathbf{R}_i — положения узлов кристаллической решетки, $u_{n\mathbf{k}'}(\mathbf{r})$ — блоховские амплитуды для *n*-й зоны, индексы $\parallel \mathbf{u} \perp$ означают направления в плоскости КЯ и вдоль оси роста гетероструктуры соответственно. Для фигурирующих в правой части (1) огибающих волновых функций непрерывного спектра $\varphi_n(z)$ воспользуемся следующими



Рис. 2. Гетероструктура с зонной схемой типа I с глубокой квантовой ямой для электронов. Вертикальные линии со стрелками обозначают поглощение фотонов $\hbar\omega$. Жирными линиями со стрелками показан процесс оже-типа с участием фотона $c_3 + v_1 + \hbar\omega \rightarrow 2c_1$. Помимо фотопереходов, показанных на этом рисунке, в формировании ФЛ участвуют и процессы, показанные на рис. 1.

выражениями:

$$\varphi_{n}^{(-)}(z) = \Xi_{n}^{(-)} \begin{cases} \sin k_{n}z, & 0 \le z \le 1, \\ \frac{\sin K_{n}}{\sin(\Phi_{n}-K_{n})\sin(\Phi_{n}-z)} & 1 \le z \le 1, \end{cases}$$

$$\Xi_{n}^{(-)}(k_{n}) = \left[l \left(\sin^{2} k_{n} + \frac{k_{n}^{2}}{K_{n}^{2}}\cos^{2} k_{n} \right) \right]^{-1/2}, \quad (2)$$

$$\Phi_{n} = \arctan\left(\frac{\tan K_{n} - \frac{K_{n}}{k_{n}}\tan k_{n}}{1 + \frac{K_{n}}{k_{n}}\tan k_{n}\tan K_{n}} \right),$$

где

$$K_n^2 = k_n^2 - k_{0n}^2, \quad U_n = \hbar^2 k_{0n}^2 / (2m_n a^2),$$

 $n = (c, v), m_c$ и m_v — эффективные массы электронов и дырок, l — нормировочная длина. Для волновых функций состояний дискретного спектра имеем

$$\begin{split} \varphi_{n,i}^{(+)} &= \Upsilon_n^{(+)} \begin{cases} \cos k_{n,i}z, & 0 \le z \le 1, \\ \cos k_{n,i}e^{\kappa_n(1-z)}, z > 1, \end{cases} \\ p_{n,i}^{(-)} &= \Upsilon_n^{(-)} \begin{cases} \cos k_{n,i}z, & 0 \le z \le 1, \\ \cos k_{n,i}e^{\kappa_n(1-z)}, z > 1, \end{cases} \\ \Upsilon_n^{(\pm)}(k_{n,i}) &= (1 + \kappa_{n,i})^{-1/2}, \quad k_{n,i}^2 = k_{0n}^2 - \kappa_{n,i}^2. \end{split}$$

Для четных и нечетных состояний значения $k_{n,i}$ являются корнями трансцендентных уравнений соответственно

$$\tan k_{n,i} = \kappa_{n,i}/k_{n,i}, \quad \text{i} \quad \cot k_{n,i} = -k_{n,i}/\kappa_{n,i}.$$
 (4)

Энергии уровней в КЯ даются формулой

$$E_{n,i}^{(0)} = -\hbar^2 \kappa_{n,i}^2 / (2m_n a^2), \tag{5}$$

Волновые векторы и длины в формулах (2)-(5) выражены в единицах a^{-1} и a, где a — полуширина КЯ.

Вероятность процесса оже-типа с поглощением фотона

В этом разделе мы впервые рассмотрим вероятность перехода $c_3 + \hbar \omega \rightarrow 2c_1 + v_1$, т.е. электрон в верхней подзоне c_3 , поглощая фотон $\hbar \omega$, переходит в нижнюю подзону с1 и рождает пару, состоящую из еще одного электрона в подзоне c_1 и дырки в подзоне v_1 (рис. 2). Очевидно, что мы имеем дело с процессом второго порядка — один порядок по взаимодействию электронной системы со светом и один порядок по межэлектронному кулоновскому взаимодействию. Формально имеется множество каналов процесса второго порядка, однако в случае рассматриваемого перехода преобладающий вклад в амплитуду процесса дает лишь один канал, которому соответствует фейнмановская диаграмма, приведенная на рис. 3. Остальные диаграммы содержат либо межзонные кулоновские вершины, либо матричные элементы запрещенных межподзонных и межзонных оптических переходов в КЯ, либо матричные элементы кулоновского взаимодействия между состояниями разной четности в КЯ. Оценки вкладов других диаграмм показывают, что они оказываются на много порядков меньше вклада диаграммы на рис. 3. Для составного матричного элемента процесса 2-го порядка, соответствующего диаграмме на рис. 2, нетрудно получить следующее выражение:

$$M_{c_{3}\mathbf{k}_{3},v_{1},\mathbf{k}_{v};c_{1}\mathbf{k}_{3}-\mathbf{q},c_{1}\mathbf{k}_{v}+\mathbf{q}}^{(d)} = \frac{V_{v_{1}\mathbf{k}_{v},c_{1}\mathbf{k}_{v}}^{(d-\text{phot})}V_{c_{3}\mathbf{k}_{3},v_{1},\mathbf{k}_{v};c_{1}\mathbf{k}_{3}-\mathbf{q},c_{1}\mathbf{k}_{v}+\mathbf{q}}}{E_{v_{1}}(\mathbf{k}_{v\parallel}) - E_{c_{1}}(\mathbf{k}_{v\parallel}) + \hbar\omega},$$
(6)

где

$$V_{\upsilon_1 \mathbf{k}_{\upsilon}, c_1 \mathbf{k}_{\upsilon}}^{(\text{e-phot})} = -\frac{e}{mc} \,\mathbf{A} \cdot \mathbf{p}_{\upsilon c}(\mathbf{k}_{\upsilon}) \tag{7}$$

 матричный элемент оператора электрон-фотонного взаимодействия,

$$V_{c_{3}\mathbf{k}_{3},c_{1}\mathbf{k}_{v};c_{1}\mathbf{k}_{3}-\mathbf{q},c_{1}\mathbf{k}_{v}+\mathbf{q}}^{(d)} = \frac{2\pi e^{2}}{S\varepsilon_{l}} \int_{-l}^{l} dz_{l} \int_{-l}^{l} dz_{2} \frac{e^{-q|z_{1}-z_{2}|}}{q} \times \varphi_{c_{3}}^{*}(z_{1})\varphi_{c_{1}}(z_{1})\varphi_{c_{1}}^{*}(z_{2})\varphi_{c_{1}}(z_{2})$$

$$(8)$$

— матричный элемент оператора электрон-электронного кулоновского взаимодействия, который легко получается за счет разложения энергии кулоновского взаимодействия в ряд Фурье и ряда стандартных преобразований. Индексом (d) отмечен прямой матричный



Рис. 3. Фейнмановская диаграмма для процесса $c_3 + \hbar \omega \rightarrow 2c_1 + v_1$. Прямые линии со стрелками вправо — электроны, со стрелкой влево — дырка, волнистая линия — фотон $\hbar \omega$, штриховая линия — кулоновское взаимодействие.

элемент, а индексом (e) будет ниже отмечен обменный матричный элемент.

В формулах (6)–(8) использованы следующие обозначения: е и m — заряд и масса свободного электрона, S — нормировочная площадь КЯ, c — скорость света в вакууме, **A** — вектор-потенциал электромагнитного поля, \mathbf{p}_{vc} — межзонный матричный элемент оператора импульса, построенный на блоховских фукциях валентной зоны и зоны проводимости, ε_l и ε_l — продольная и поперечная высокочастотные диэлектрические проницаемости. Последняя входит в соотношение, связывающее вектор-потенциал и интенсивность света *j*:

$$|\mathbf{A}^2| = -\frac{8\pi c}{\omega^2 \sqrt{\varepsilon_t}} j$$

Вероятность перехода $c_3 + \hbar \omega \rightarrow 2c_1 + v_1$ дается выражением

$$\begin{split} W_{c_{3},v_{1};c_{1},c_{1}} &= \frac{2\pi}{\hbar} \left[\frac{S}{(2\pi)^{2}} \right]^{2} \int \int d^{2}q d^{2}k_{v\parallel} \\ &\times |M_{c_{3}\mathbf{k}_{3},v_{1}\mathbf{k}_{\parallel v};c_{1}\mathbf{k}_{3}-\mathbf{q},c_{1}\mathbf{k}_{\parallel v}+\mathbf{q}} + M_{c_{3}\mathbf{k}_{3},v_{1}\mathbf{k}_{\parallel v};c_{1}\mathbf{k}_{3}-\mathbf{q},c_{1}\mathbf{k}_{\parallel v}+\mathbf{q}}^{(e)} \\ &\times \delta \left[\Delta_{\mathrm{thr}} + \frac{\hbar^{2}k_{3}^{2}}{2m_{c}} - \frac{\hbar^{2}k_{\parallel v}^{2}}{2m_{v}} - \frac{\hbar^{2}(\mathbf{k}_{3}-\mathbf{q})^{2}}{2m_{c}} - \frac{\hbar^{2}(\mathbf{k}_{\parallel v}+\mathbf{q})^{2}}{2m_{c}} \right], \end{split}$$

где

$$\Delta_{\rm thr} = E_{c,3}^{(0)} + \hbar\omega - 2E_{c,1}^{(0)} - E_g - E_{v,1}^{(0)}.$$
 (10)

(9)

Очевидно, что переход $c_3 + \hbar \omega \rightarrow 2c_1 + v_1$ возможен лишь при $\Delta_{\rm thr} > 0$.

Дальнейшие вычисления можно несколько упростить, воспользовавшись тем, что внутриподзонная релаксация является самым быстрым процессом для электронов в подзоне c_3 , так что все электроны в этой подзоне оказываются вблизи ее дна, и мы можем считать, что $\mathbf{k}_3 = 0$. После некоторых вычислений получаем следующее выражение для вероятности перехода $c_3 + \hbar \omega \rightarrow 2c_1 + v_1$:

$$W_{c_{3},v_{1};c_{1},c_{1}} \cong \frac{2^{8}\pi^{2}e^{6}a^{4}|p_{cv}|^{2}m_{r}m_{c}^{2}\eta}{c\hbar^{7}\omega^{2}m^{2}\varepsilon_{l}^{2}\varepsilon_{l}^{1/2}\gamma_{1}^{2}} j\alpha^{2}$$
$$\times \int_{0}^{\xi} \frac{\exp(-2\beta q^{3/4})qdq}{|\sigma - q^{2}|^{2}}, \qquad (11)$$

где множитель η , мало отличающийся от единицы, описывает слабую интерференцию прямого и обменного вкладов в матричный элемент,

$$\sigma = 2(a^2/\hbar)\gamma_1 m_c \omega_{31}, \quad \xi \equiv \xi(\Delta_{\text{thr}}) = (a/\hbar)\sqrt{2m_c \gamma \Delta_{\text{thr}}},$$
$$m_r^{-1} = m_c^{-1} + m_v^{-1}, \quad \gamma = [2 - m_r/(2m_c)]^{-1},$$
$$\gamma_1 = [1 - m_r/(2m_c)], \quad \hbar \omega_{ij} = E_{c,i}^{(0)} - E_{c,j}^{(0)}, \quad (12)$$

 α и β — величины, слабо зависящие от параметров задачи (тем не менее, они вычисляются отдельно для каждого из наборов значений параметров). Их типичные значения таковы: $\alpha \approx 0.17$, $\beta \approx 0.75$. Зависимость вероятности $W_{c_3,v_1;c_1,c_1} \equiv 1/\tau_{2,aug}$ от Δ_{thr} дается на рис. 4. При интенсивности света j = 1 MW/cm² типичные значения $\tau_{2,aug}$ составляют $10^{-10} - 10^{-11}$ s, что указывает на существенную роль процесса $c_3 + \hbar\omega \rightarrow 2c_1 + v_1$ в кинетике нелинейного фотовозбуждения гетероструктуры с глубокими КЯ.

Вероятности оптических переходов

Переходы между состояниями в квантовой яме и состояниями непрерывного спектра. В рассматриваемой модели гетероструктуры с глубокими КЯ актуальны два типа таких переходов: фотопереходы между состояниями на дне подзоны с₃ ямы для электронов и



Рис. 4. Зависимость вероятности перехода $c_3 + \hbar \omega \rightarrow 2c_1 + v_1$ от превышения Δ_{thr} энергии фотона над пороговым для этого перехода значением. В расчете использованы следующие значения параметров: $1 - U_c = 1.2, 2 - 0.9, 3 - 0.6$ eV. Для всех кривых значения остальных параметров: $U_v = 0.4, E_g = 0.55$ eV, $|p_{vc}| = 2 \cdot 10^{-19}$ g · cm · s⁻¹, $\varepsilon_l = 5, \varepsilon_t = 3, j = 1.0$ MW · cm⁻².



Рис. 5. Зависимость вероятности переходов $c_3 \rightarrow$ континуум от энергии кванта света $\hbar \omega$: $1 - U_c = 0.9 \text{ eV}$, $m_c = 0.12m$, a = 2.1 nm; $2 - U_c = 1.2 \text{ eV}$, $m_c = 0.2m$, a = 1.5 nm. Остальные параметры $\varepsilon_t = 6$, $j = 1 \text{ MW/cm}^2$. Точки на кривых соответствуют $\hbar \omega = \hbar \omega_{32}$.

состояниями непрерывного спектра зоны проводимости и фотопереходы дырок из состояния в подзоне v_1 в яме для дырок и состояниями континуума в валентной зоне. Для вероятности переходов $c_3 \rightarrow$ континуум зоны проводимости получаем выражение

$$W_{c_{3,c}} = \frac{16\pi e^2 m_c}{m^2 c \hbar \omega^2 \sqrt{\varepsilon_t} K_\omega} j |M_{c_{3,c}}(\hbar \omega)|^2, \qquad (13)$$

где $K_{\omega} = a \hbar^{-1} \sqrt{2m_c (E_{c3}^{(0)} + \hbar \omega - U_c)}$, а безразмерный составной матричный элемент имеет вид

$$M_{c_{3},c}(\hbar\omega) = 2\Xi_{c}^{(-)}(k_{\omega})\Upsilon_{c}(k_{c,3})$$

$$\times \left[\frac{\kappa_{c}(k_{c,3})\sin k_{\omega}\cos k_{c,3}}{\sin(\Phi_{\omega} - K_{\omega})}\right]$$

$$\times \frac{K_{\omega}\cos(K_{\omega} - \Phi_{c,3}) + \kappa_{c}(k_{c,3})\sin(K_{\omega} - \Phi_{c,3})}{K_{\omega}^{2} + \kappa_{c}(k_{c,3})^{2}}$$

$$- k_{c,3}\frac{k_{c,3}\cos k_{c,3}\sin k_{\omega} - k_{\omega}\cos k_{\omega}\sin k_{c,3}}{k_{\omega} - k_{c,3}}\right]. \quad (14)$$

В (14) использованы обозначения

$$k_{\omega} = a \hbar^{-1} [2m_c (E_{c3}^{(0)} + \hbar \omega)]^{1/2}, \quad \Phi_{\omega} = \Phi_c (K_{\omega}, k_{\omega}),$$

см. также формулы (2)–(5).

Зависимости $W_{c_{3},c}$ от $\hbar\omega$ даются на рис. 5. Для вероятности перехода $W_{v_{1},v}$ дырки из подзоны v_{1} в непрерывный спектр валентной зоны справедливы соотношения, аналогичные (13), (14) с очевидными заменами U_{c} , m_{c} , $k_{c,3}$, $E_{c_{3}}^{(0)} \rightarrow U_{v}$, m_{v} , $k_{v,1}$, $E_{v1}^{(0)}$. Зависимости $W_{v_{1},v}$ от $\hbar\omega$ приведены на рис. 6.

Межзонные двухфотонные переходы. Вероятность межзонного двухфотонного перехода в КЯ типа I равна

$$\frac{W_{v_1,c_2}^{(2)}}{S} = \frac{2\pi}{\hbar} \int d\mathbf{k}_{v\parallel}^2 |M_{v_1,c_2}^{(2)}|^2 \\ \times \delta(2\hbar\omega - E_g - E_{v,1}^{(0)} - \hbar^2 \mathbf{k}_{v\parallel}^2/2m_r), \quad (15)$$



Рис. 6. Зависимость вероятности переходов $v_1 \rightarrow$ континуум валентной зоны от энергии кванта света $\hbar \omega$: $1 - U_v = 0.3$ eV, $m_v = 0.7m$, a = 2.1 nm; $2 - U_v = 0.2$ eV, $m_v = 0.6m$, a = 1.5 nm. Остальные параметры $\varepsilon_t = 6$, j = 1 MW/cm².



Рис. 7. Зависимость вероятности ДФП $v_1 \rightarrow c_2$ от $\hbar \omega$: $m_c = 0.2m, m_v = 0.6m, a = 1.5 \text{ nm}, U_c = 1.0 \text{ eV}, U_v = 0.4 \text{ eV},$ $E_g = 0.3 \text{ eV}, |p_{vc}| = 2 \cdot 10^{-19} \text{ g} \cdot \text{cm} \cdot \text{s}^{-1}, \varepsilon_t = 4, j = 1 \text{ MW/cm}^2.$

где составной матричный элемент перехода определяется выражением

$$M_{\nu_1 c_2}^{(2)} = \frac{V_{\nu_1, c_1}^{(e-\text{phot})} V_{c_1, c_2}^{(e-\text{phot})}}{\hbar \omega_{21} - \hbar \omega}.$$
 (16)

Окончательно для вероятности перехода имеем

$$\frac{W_{c_{1}c_{2}}^{(2)}}{S} = \frac{(8\pi)^{2}m_{r}e^{4}p_{vc}^{2}}{a^{2}\hbar m^{2}m_{c}^{2}c^{2}\omega^{4}\varepsilon_{t}}|\xi_{12}|^{2} \\ \times \left(\frac{j}{\hbar\omega_{21}-\hbar\omega}\right)^{2}\theta(2\hbar\omega-E_{g}-E_{v,1}^{(1)}-E_{c,2}^{(0)}),$$
(17)

где

$$\xi_{ij} = -i \int\limits_{-\infty}^{\infty} \varphi_{ci}^*(z) \nabla \varphi_{cj}(z) dz,$$

 $\varphi_{ci}(z)$ — огибающие волновые функции для электронов в КЯ, см. формулы (3), причем ξ_{ij} — безразмерные величины.

Типичная зависимость этой вероятности от $\hbar \omega$ приведена на рис. 7.

Заключение

Таким образом, в настоящей работе впервые вычислена вероятность процесса 2-го порядка $c_3 + \hbar \omega \rightarrow$ $\rightarrow v_1, 2c_1$, а также приведены вероятности других оптических переходов, которые наряду с рассмотренными ранее переходами внутри ямы для электронов участвуют в процессе фотонной лавины в гетероструктуре типа I с глубокими квантовыми ямами. Рассмотрение кинетики нелинейного возбуждения таких гетероструктур будет проведено в следующей части данной работы, где будут учтены процессы межподзонной релаксации электронов, процессы захвата электронов из состояний непрерывного спектра в состояния подзон размерного квантования, а также процессы рекомбинации электронов и дырок. Будут также указаны конкретные гетероструктуры, в которых возможна экспериментальная реализация рассмотренных процессов.

Работа выполнена при государственной финансовой поддержке ведущих университетов Российской Федерации (субсидия 08-08), базовой части государственного задания в сфере научной деятельности — проект 5.4681.2017/6.7.

Список литературы

- Chivian J.S., Case W.E., Eden D.D. // Appl. Phys. Lett. 1979.
 V. 35. N 2. P. 124. doi 10.1063/1.91044
- [2] Kueny A.W., Case W.E., Koch M.E. // J. Opt. Soc. Am. B. 1989. V. 6. N 4. P. 639. doi 10.1364/JOSAB.6.000639
- Koch M.E., Kueny A.W., Case W.E. // Appl. Phys. Lett. 1990.
 V. 56. N 12. P. 1083. doi 10.1063/1.103328
- [4] Ni H., Rand S.C. // Opt. Lett. 1991. V. 16. N 18. P. 1424. doi 10.1364/OL.16.001424
- [5] Chen Y., Auzel F. // J. Phys. D.: Appl. Phys. 1995. V. 28. N 1.
 P. 207. doi 10.1088/0022-3727/28/1/029
- [6] Auzel F., Chen Y.H. // J. Non-Crystalline Solids. 1995. V. 184.
 P. 57. doi 10.1016/0022-3093(94)00595-8
- [7] Auzel F. // Acta Physica Polonica A. 1996. V. 90. N 1. P. 7. doi 10.12693/APhysPolA.90.7
- [8] Pellé F., Goldner P. // Acta Physica Polonica A. 1996. V. 90.
 N 1. P. 197. doi 10.12693/APhysPolA.90.197
- [9] Guy S., Joubert M.-F., Jacquier B. // Phys. Rev. B. 1997. V. 55.
 N 13. P. 8240. doi 10.12693/APhysPolA.90.197
- [10] Joubert M.-F. // Opt. Materials. 1999. V. 11. P. 181. doi 10.1016/S0925-3467(98)00043-3
- [11] Gatch D.B., Dennis W.M., Yen W.M. // Phys. Rev. B. 2000.
 V. 62. N 16. P. 10790. doi 10.1103/PhysRevB.62.10790
- [12] Hehlen M.P., Kuditcher A., Lenef A.L., Ni H., Shu Q., Rand S.C., Rai J., Rai S. // Phys. Rev. B. 2000. V. 61. N 2. P. 1116. doi 10.1103/PhysRevB.61.1116
- [13] Перлин Е.Ю., Ткачук А.М., Joubert М.-F., Moncorge R. // Опт. и спектр. 2001. Т. 90. № 5. С. 772; Perlin E.Yu., Tkachuk A.M., Joubert M.-F., Moncorge R. // Opt. Spectrosc. 2001. V. 90. N 5. P. 691. doi 10.1134/1.1374657

Оптика и спектроскопия, 2018, том 125, вып. 6

817

- Jouart J.P., Bouffard M., Duvaut D. // Chem. Phys. Lett. 2002.
 V. 366. N 1–2. P. 62. doi 10.1016/S0009-2614(02)01537-3
- [15] Lavín V., Lahoz F., Martín I.R., Rodríguez-Mendoz U.R., Cáceres J.M. // Opt. Materials. 2005. V. 27. N 11. P. 1754. doi 10.1016/joptmat.2004.11.046
- [16] Boulma E., Jouart J.P., Bouffard M., Diaf M., Doualan J.L., Moncorgé R. // Opt. Materials. 2007. V. 30. N 7. P. 1028. doi 10.1016/j.optmat.2007.05.005
- [17] Compton S.P. Upconversion and Near Infrared Spectroscopy of Erbium doped Calcium Sulfide. PhD Thesis. The University of Georgia. Athens, Georgia, 2009. 62 p.
- [18] Singh A.K., Kumar K., Pandey A.C., Parkash O., Rai S.B., Kumar D. // Appl. Phys. B. 2011. V. 104. P. 1035. doi 10.1007/s00340-011-4673-2
- [19] Verma R.K., Singh S.K., Rai S.B. // Current Appl. Phys. 2012.
 V. 12. N 6. P. 1481. doi 10.1016/j.cap.2012.04.018
- [20] Babu P, Martín I.R., Krishnaiah K.V., Seo H.J., Venkatramu V., Jayasankar C.K., Lavín V. // Chem. Phys. Lett. 2014. V. 600. P. 34. doi 10.1016/j.cplett.2014.03.048
- [21] Rathaiah M., Martín I.R., Babu P., Lingannaa K., Jayasankar C.K., Lavín V., Venkatramu V. // Opt. Materials. 2015. V. 39. N 1. P. 16. doi 10.1016/j.optmat.2014.10.050
- [22] Perlin E.Yu. // J. Luminesc. 2001. V. 94–95. P. 249. doi 10.1016/S0022-2313(01)00288-5
- [23] Перлин Е.Ю. // Опт. и спектр. 2001. Т. 91. № 5. С. 777; Perlin E.Yu. // Opt. Spectrosc. 2001. V. 91. N 5. P. 729. doi 10.1134/1.1420854
- [24] Перлин Е.Ю., Иванов А.В., Левицкий Р.С. // ЖЭТФ. 2003.
 Т. 123. № 3. С. 612; Perlin E.Y., Ivanov A.V., Levitskii R.S. // JETP. 2003. V. 96. Р. 543. doi 10.1134/1.1567429
- [25] Левицкий Р.С., Иванов А.В., Перлин Е.Ю. // Опт. журн. 2006. Т. 73. № 2. С. 3; Levitskii R.S., Ivanov A.V., Perlin E.Yu. // J. Opt. Technol. 2006. V. 73. N 2. P. 71. doi 10.1364/JOT.73.000071
- [26] Рывкин С.М. // ФТТ. 1965. Т. 7. № 4. С. 1276.
- [27] Рывкин С.М., Гринберг А.А., Крамер Н.И. // ФТТ. 1965.
 Т. 7. В. 7. С. 2195; Ryvkin S.M., Grinberg А.А., Kramer N.I. // Sov. Phys. Solid State. 1965. V. 7. N 7. P. 1038.
- [28] Гринберг А.А., Рогачев А.А., Рывкин С.М. // ФТТ. 1965.
 Т. 7. В. 7. С. 2206. Betzler K., Weller T., Conradt R. // Phys. Rev. B. 1972. V. 6. N 4. Р. 1394. doi 10.1103/PhysRevB.6.1394
- [29] Перлин Е.Ю., Федоров А.В., Кашевник М.Б. // ЖЭТФ. 1983. Т. 85. № 4. С. 1357; Perlin E.Yu., Fedorov A.V., Kashevnik M.B. // Sov. Phys. JETP. 1983. V. 58. N 4. P. 787.
- [30] Данишевский А.М., Перлин Е.Ю., Федоров А.В. // ЖЭТФ. 1987. Т. 93. № 4. С. 1319; Danishevskii А.М., Perlin E.Yu., Fedorov A.V. // Sov. Phys. JETP. 1987. V. 66. N 4. P. 747.
- [31] Перлин Е.Ю., Иванов А.В., Левицкий Р.С. // ЖЭТФ. 2005. Т. 128. № 2. С. 411–421; Perlin E.Yu., Ivanov A.V., Levitskii R.S. // JЕТР. 2005. V. 101. N 2. P. 357. doi 10.1134/1.2047802
- [32] Перлин Е.Ю., Иванов А.В., Попов А.А. // Опт. и спектр. 2012. Т. 113. № 4. С. 418; Perlin E.Yu., Ivanov A.V., Popov A.A. // Opt. Spectrosc. 2012. V. 113. N 4. Р. 376. doi 10.1134/S0030400X12100074
- [33] Перлин Е.Ю., Иванов А.В., Попов А.А. // Опт. и спектр. 2012. Т. 113. № 4. С. 426; Perlin E.Yu., Ivanov A.V., Popov A.A. // Opt. Spectrosc. 2012. V. 113. N 4. P. 383. doi 10.1134/S0030400X12100086
- 52 Оптика и спектроскопия, 2018, том 125, вып. 6

[34] Перлин Е.Ю., Иванов А.В., Попов А.А. // Опт. и спектр. 2013. Т. 115. № 5. С. 830; Perlin E.Yu., Ivanov A.V., Popov A.A. // Opt. Spectrosc. 2013. V. 115. N 5. P. 739. doi 10.1134/S0030400X13110179